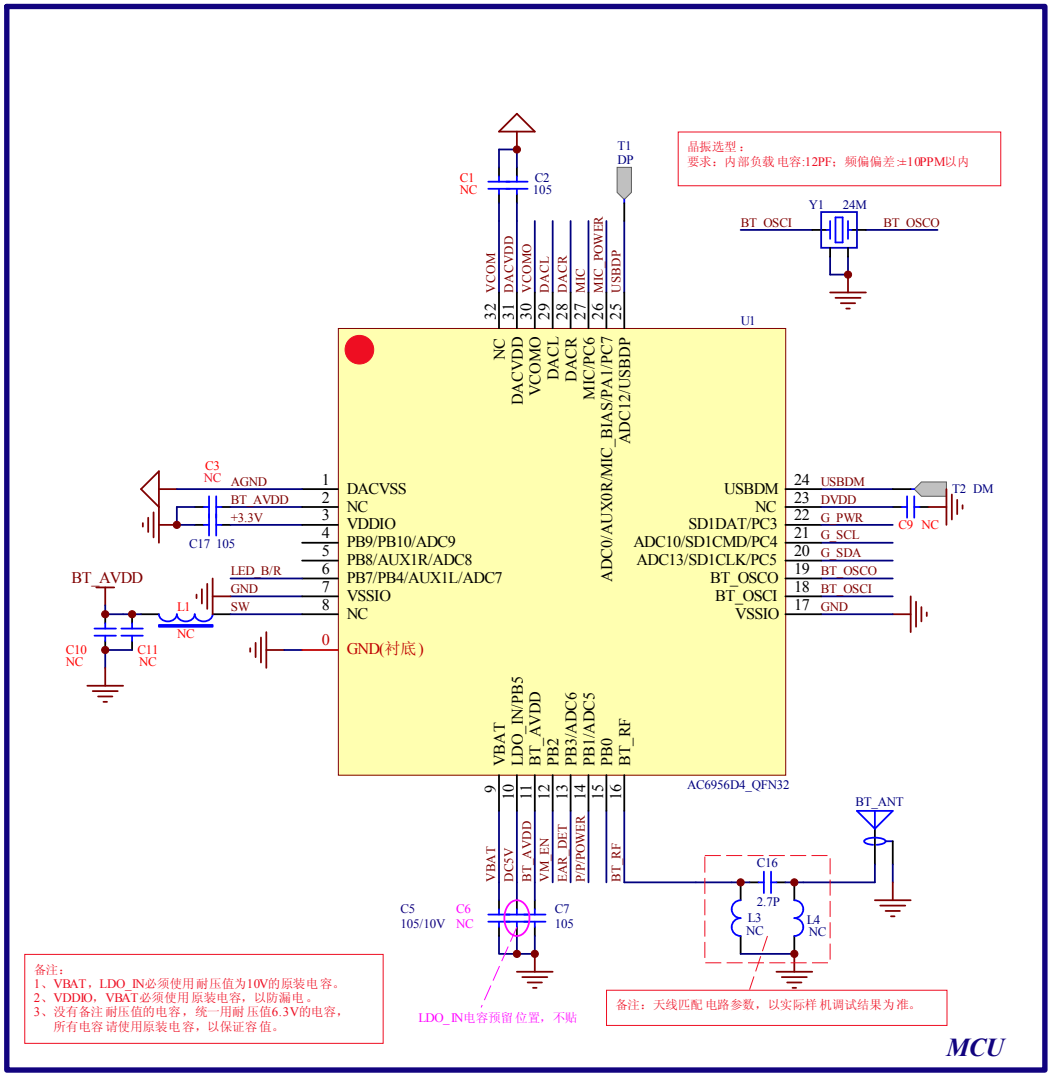
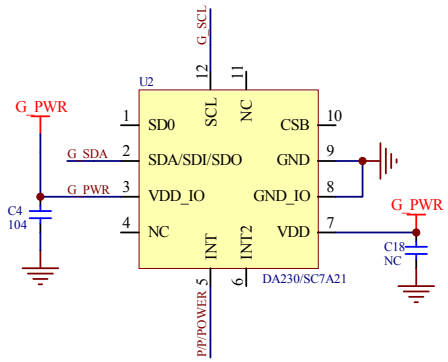
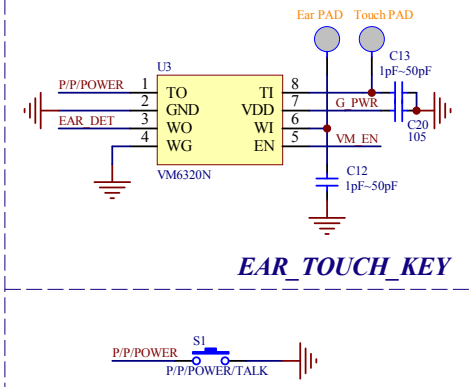
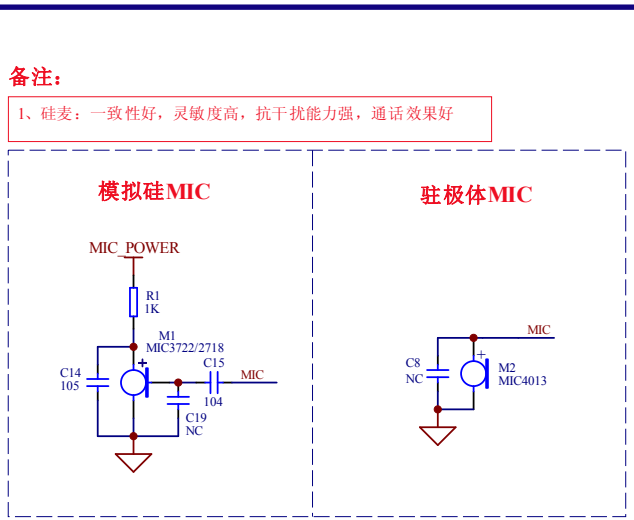
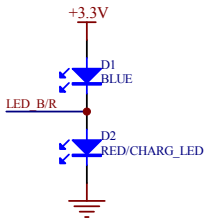

晶振选型：
要求：内部负载电容:12PF；频偏偏差±10PPM以内
U1
AC6956D4_QFN32
DACVSS
NC
VDDIO
PB9/PB10/ADC9
PB8/AUX1R/ADC8
PB7/PB4/AUX1L/ADC7
VSSIO
NC
GND(衬底)
USBDM
NC
SD1DAT/PC3
ADC10/SD1CMD/PC4
ADC13/SD1CLK/PC5
BT_OSCO
BT_OSCI
VSSIO
NC
DVDD
G_PWR
G_SCL
G_SDA
BT_OSCO
BT_OSCI
GND
ADC0/AUX0R/MIC_BIAS/PA1/PC7
ADC12/USBDP
MIC/PC6
DACR
VCOMO
DACVDD
VBAT
LDO_IN/PB5
BT_AVDD
PB2
PB3/ADC6
PB1/ADC5
PB0
BT_RF
DC5V
VM_EN
EAR_DET
P/P/POWER
Y1 24M
BT_ANT
LED_B/R
BT_AVDD
+3.3V
LDO_IN电容预留位置，不贴
备注：天线匹配 电路参数，以实际样 机调试结果为准。
备注：
1、VBAT，LDO_IN必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注 耐压值的电容，统一用耐 压值6.3V的电容，
所有电容 请使用原装电容，以保证容值。
MCU

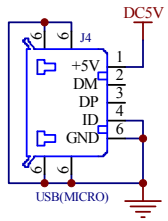

U2
SD0
SDA/SDI/SDO
VDD_IO
NC
SCL
NC
CSB
GND
GND_IO
VDD
INT
INT2
DA230/SC7A21
G_PWR
G_SDA
G_SCL
P/P/POWER
G-SENSOR

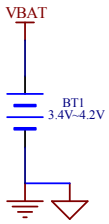

Ear PAD
Touch PAD
U3
TO
GND
WO
WG
TI
VDD
WI
EN
VM6320N
P/P/POWER
EAR_DET
G_PWR
VM_EN
EAR_TOUCH_KEY

P/P/POWER
S1
P/P/POWER/TALK
KEY


备注：
1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好
模拟硅MIC
MIC_POWER
R1
1K
M1
MIC3722/2718
MIC
驻极体MIC
MIC
M2
MIC4013
DACL
DACR
J5
Earphone
MIC电路处的滤波电容位置需预留
Mic、Earphone


+3.3V
D1
BLUE
LED_B/R
D2
RED/CHARG_LED
LED


DC5V
J4
+5V
DM
DP
ID
GND
USB(MICRO)


VBAT
BT1
3.4V~4.2V
备注：
1、GND、AGND在电池地 处短接在一起！
2、电池必须 使用带保护板 的电池
POWER